

性能特点

- 频率范围：10~1000MHz
- 采用有源偏置设计提供温度补偿
- 良好的50Ω阻抗匹配，易级联使用
- 微波薄膜电路结构，电性能稳定可靠
- 采用标准全密封管壳封装
- 满足军温工作条件：-55℃~+85℃

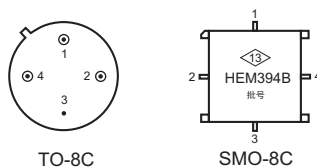
电性能表 (50Ω测试系统, $V_{CC}=+5V$, $T_A=-55^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$)

性能参数	符号	单位	规范值	典型值
频率范围	$f_L \sim f_H$	MHz	10~1000	10~1000
小信号功率增益	G_p	dB	≥ 15.0	16.0
增益平坦度	ΔG_p	dB	$\leq \pm 0.5$	± 0.3
噪声系数	F_n	dB	$\leq 4.5 \Delta$	--
输入驻波比	VSWRi	--	$\leq 2.0:1$	1.7:1
输出驻波比	VSWRo	--	$\leq 2.0:1$	1.6:1
线性输出功率	P_{-1}	dBm	$\geq 15.0 \Delta$	16.0
工作电流	I_{CC}	mA	--	60

注：“*” $f=700MHz$ ；规范值中带“Δ”的参数为常温参数。

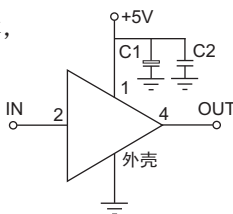
极限参数

最高电源电压：+6VDC
最大输入功率：+10dBm
最高储存温度：+125℃



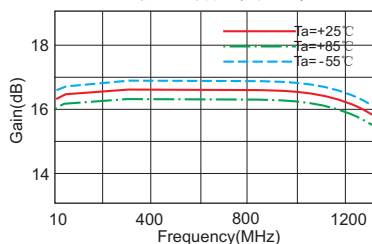
使用说明

1. 电路按右图连接，内部集成有耦合电容， $C_1=3.3 \sim 22 \mu F$ ； $C_2=3300 \sim 6800pF$ ；
2. 可与AVANTEK公司UTO-1007；W-J公司A28-2替代使用；
3. 可提供盒体结构(SMA输出)SMA-1封装类型的产品；
4. 外形尺寸和安装使用方法见本册附后的《封装外形尺寸及安装使用说明》页。

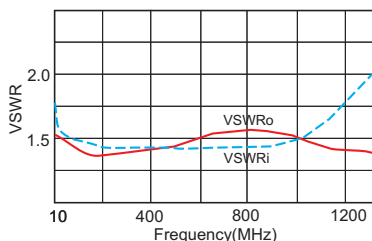


典型曲线

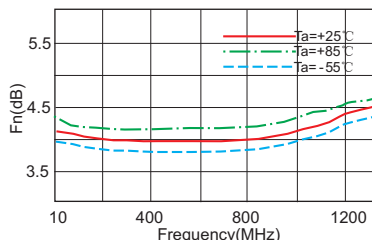
增益与频率曲线



驻波比与频率曲线



噪声与频率曲线



功率与频率曲线

